

M3FE40

400V 1.2A

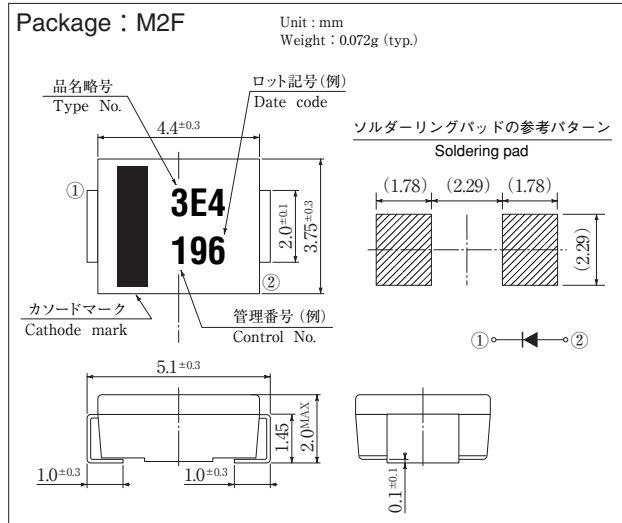
特長

- 耐湿性に優れ高信頼
- 静電気耐性に優れている
- 自動実装対応

Feature

- High-Reliability
- High ESD Capability
- for Auto-Mount

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

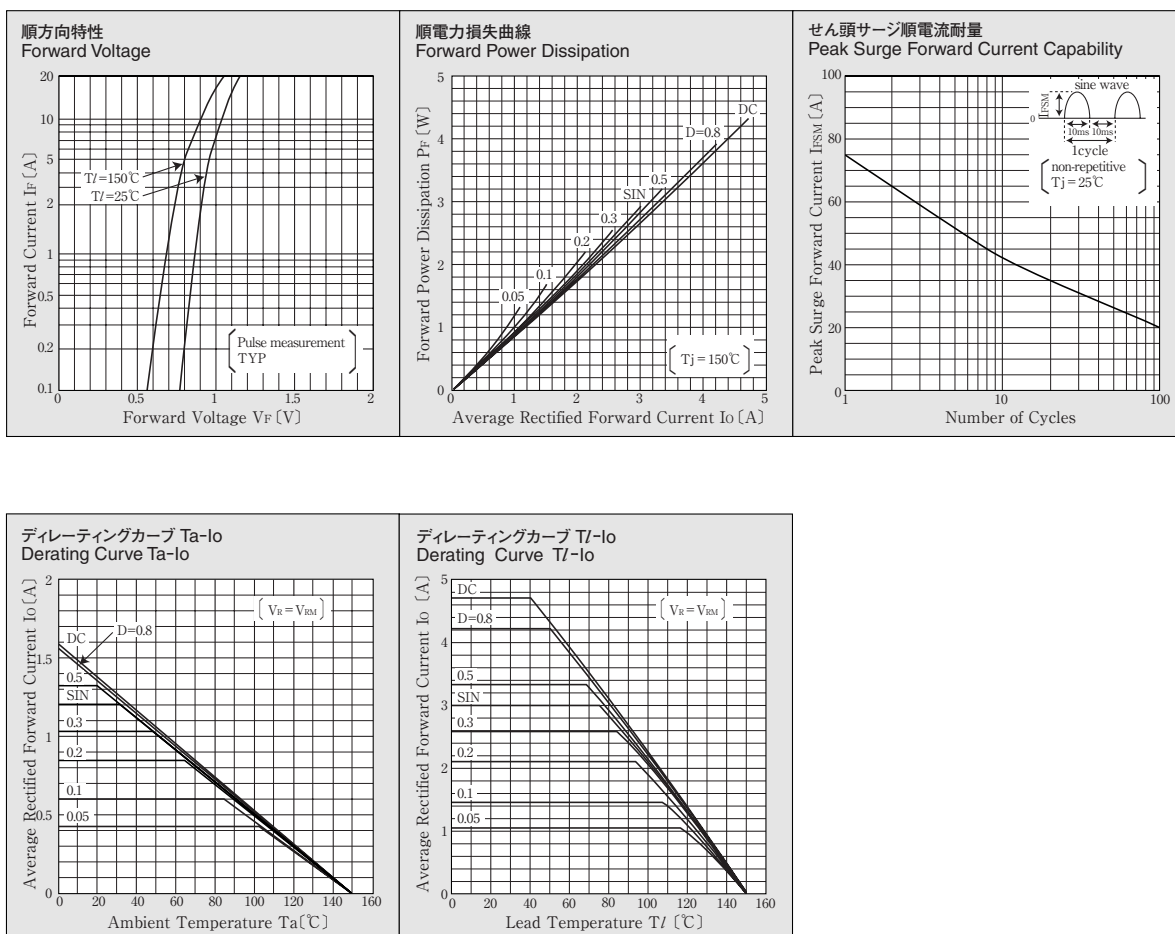
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	M3FE40	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			400	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 50Hz sine wave, Resistance load	プリント基板実装 On glass-epoxy substrate Ta=32°C	1.2	A
			Tl=76°C	3	
せん頭サーシ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25°C		75	A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I ² t	1ms ≤ t < 10ms Tc=25°C		28	A ² s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は $T_l = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F =3A, パルス測定 Pulse measurement	MAX	1.1	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R =400V, パルス測定 Pulse measurement	MAX	10	μA
静電気耐性 Electrostatic Discharge Capability	V _{ESD}	C=150pF, R=150Ω 極性±, 気中放電 Polarity±, Aerial discharge *1	TYP	30	kV
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間, プリント基板実装 Junction to Lead, On epoxy-glass substrate	MAX	25	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間, プリント基板実装 Junction to Ambient, On epoxy-glass substrate	MAX	110	
	θ _{jc}	接合部・ケース間, プリント基板実装 Junction to Case, On epoxy-glass substrate	MAX	25	

*1: IEC-61000-4-2規定に準拠
It is based on IEC-61000-4-2.

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.